

前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減 租稅優惠介紹

產業創新條例於在 112 年 1 月間增修訂一項租稅優惠，係對前瞻創新研究發展支出及設備支出的投資抵減，此目的為強化產業國際競爭優勢，並鞏固我國產業全球供應鏈之地位，適用於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，同時於 112 年 8 月間公司細部辦法，此優惠適用期間自中華民國 112 年 1 月 1 日至 118 年 12 月 31 日止。本文特別對於此規定內容，整理提供分享，作為相關企業組織未來稅務規劃或申報應用時的參考。

一、產創條例內容介紹

適用條件對象及金額限制

前瞻創新支出投資抵減規定於第十條之二，於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位之公司，符合適用的條件如下：

- 一、在同一課稅年度內之研究發展費用及研究發展費用占營業收入淨額比率達一定規模。
- 二、當年度有效稅率未低於一定比率。
- 三、最近三年內無違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大情事。

得抵減當年度應納營利事業所得稅額的金額限制為當年度投資於前瞻創新研究發展支出金額百分之二十五，但以不超過其當年度應納營利事業所得稅額百分之三十為限。

符合前項所定要件之公司，其當年度購置自行使用於先進製程之全新機器或設

備達一定規模者，得於支出金額百分之五，抵減當年度應納營利事業所得稅額，並以不超過其當年度應納營利事業所得稅額百分之三十為限。

同時適用申請抵減的當年度全部研究發展支出，不得適用第其他法律為鼓勵研究發展目的提供之所得稅優惠；同時當年度全部購置機器及設備支出，亦不得適用其他法律規定機器或設備投資之所得稅優惠。

公司於同一年度申請核准適用此投資抵減或與產創條例或其他法律規定之投資抵減合併適用時，其當年度合計得抵減總額以不超過當年度應納營利事業所得稅額百分之五十為限。但依其他法律規定當年度為最後抵減年度且抵減金額不受限制者，不在此限。

有效稅率限制標準

為符合國際之間適用最低稅負的基本政策，本優惠政策特別定規定有效稅率及過度時間的調整作法，此規定加上前述金額上限的條件，直接限制本優惠政策的效果，適用條件中的有效稅率，係指公司當年度依所得稅法依規定計算之應納稅額，減除依境外所得來源國稅法規定繳納之所得稅可扣抵之稅額、大陸地區來源所得在大陸地區及第三地區已繳納之所得稅可扣抵之稅額、依產創條例及其他法律規定之投資抵減稅額後之餘額，占其全年所得額之比率。

有效稅率的一定比率，112 年度為百分之十二，自 113 年度起為百分之十五，但 113 年度之一定比率，得由中央主管機關會同財政部審酌國際間施行經濟合作暨發展組織全球企業最低稅負制情形調整為百分之十二，報請行政院核定後，由經濟部會同財政部公告之。

二、投資抵減辦法的細部規定

於 112 年 8 月 7 日經濟部公告相關此租稅優惠的細部辦法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」，全文共 23 條，於此整理部分重要規定，提供今年（112 年）擬適用的公司參考，當公司同時符合各項投資抵減優惠政策情況下，可依此規定作選擇適用的評估。

適用優惠的對象細部定義

所稱居國際供應鏈關鍵地位，指公司生產之產品或提供之服務應用於涉及二個以上國家或地區之產業供應鏈，且其產品或服務於該產業供應鏈任一環節具顯著影響力。

所稱前瞻創新研究發展，指公司投入國際領先技術或成熟製造技術之創新性應用研究發展活動，其適用領域由經濟部公告。

所稱先進製程之全新機器或設備，指公司投入開發國際領先技術進行商業化量產，或發展已達商業化量產之成熟製造技術之創新性應用，所購置自行使用之全新機器及設備。

經濟部應每二年邀請相關產業界、學術界、研究機構與政府機關代表檢討之適用領域及定義。同時經濟部於 112 年 8 月 14 日公告「經授工字第 11251029960 號」函令，對 112 年至 113 年度適用的定義及領域的五大類如下：(並公告全文於工業局全球資訊網站項下)。

領 域	項 目
一、半導 體	(一) 積體電路設計 消費性電子晶片、電源管理晶片、通訊晶片、顯示晶片、高速傳輸晶片、

	<p>電子元件設計自動化 (EDA) 工具平台</p> <p>(二) 晶圓製造</p> <p>邏輯晶片製程、類比/混合訊號晶片製程、矽光子元件製程、DRAM、FLASH 與下世代記憶體製程、智慧感測應用之感測器元件製程、化合物半導體晶圓生產及元件製程</p> <p>(三) 晶圓封裝測試</p> <p>前瞻晶片封裝與測試技術，包含先進封裝設計開發、異質整合封裝技術等</p> <p>(四) 矽基半導體前段製程設備矽晶圓半導體元件 7 奈米以下製程設備</p> <p>(五) 化合物半導體製程設備</p> <p>化合物半導體碳化矽晶圓 (SiC) 長晶設備、化合物半導體有機金屬化學氣相沉積 (MOCVD) 設備</p> <p>(六) 半導體先進製程關鍵材料及化合物半導體製程用材料</p> <p>主要開發 5 奈米以下製程用材料，以及 8 吋以上碳化矽晶圓材料和高純度石墨坩堝等材料</p>
<p>二、電動車輛</p>	<p>(一) 電動汽車整車</p> <p>以電池為儲能，動力來源由馬達驅動之車輛</p> <p>(二) 自動駕駛輔助系統</p> <p>藉由雷達、光達及高精度 GPS 等技術感測環境，並融合智慧座艙等系統顯示感測結果，最終整合至車輛控制與決策系統，逐步實現自動駕駛</p> <p>(三) 馬達/驅控器</p> <p>運用新型態功率半導體並可有效提升動力效率之驅動與控制電動車輛馬達。</p> <p>(四) 車用光達</p>

	<p>可提供自動駕駛系統作為行駛判斷，運用發射脈衝雷射光來測距及成像的 車用感測器</p> <p>(五) 固態電池、電池芯</p> <p>(六) 銅箔</p> <p>車用鋰電池用之低厚度及高抗拉伸強度的銅箔。</p>
<p>三、通訊</p>	<p>(一) 基地臺射頻與天線</p> <p>5G 射頻單元通訊模組、5G 基地臺主動式大規模陣列天線 (Massive MIMO)</p> <p>(二) 基地臺系統</p> <p>5G 基地臺設備系統處理功能技術</p> <p>(三) 傳輸設備</p> <p>5G 基地台傳輸網路設備</p> <p>(四) 低軌道衛星</p> <p>低軌道衛星地面通訊終端設備與衛星通訊酬載(包含元件、模組、次系統、 系統整合等研發技術)</p>
<p>四、顯示 器</p>	<p>(一) 超高解析度面板</p> <p>8K UltraHD 之面板技術</p> <p>(二) 先進電子紙</p> <p>電泳式 (EPD) 或電致潤濕式 (EWD) 先進電子紙顯示技術</p> <p>(三) Mini/MicroLED 面板</p> <p>Mini/MicroLED 做為可直接顯示面板技術</p> <p>(四) 新型顯示技術關鍵材料</p> <p>主要開發 μ-LED 顯示器材料</p> <p>(五) Micro LED 製程設備</p>

MicroLED 晶粒尺寸單邊 15 微米以下製程設備
五、其他經審查小組同意之領域項目

適用對象的財務及其他法律要件

申請適用前瞻創新研究發展投資抵減之公司，應於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位，並符合下列資格條件：

- 一、在同一課稅年度內之研究發展費用達新臺幣六十億元。
- 二、在同一課稅年度內之研究發展費用占營業收入淨額比率達百分之六。
- 三、當年度有效稅率未低於下列比率：
 - (一) 112 年度為百分之十二。
 - (二) 自 113 年度起為百分之十五。但 113 年度得由本部會同財政部審酌國際間施行經濟合作暨發展組織全球企業最低稅負制情形調整為百分之十二，報請行政院核定後，由經濟部會同財政部公告之。
- 四、最近三年內無違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大情事。

申請適用先進製程之全新機器或設備投資抵減者，除應符合前述規定，且其同一課稅年度購置自行使用於先進製程之全新機器或設備之支出總金額達新臺幣一百億元。且有關研究發展費用及營業收入淨額，以公司經會計師查核簽證之當年度個體綜合損益表金額為準。

依規定計算後之餘額及全年所得額，以稅捐稽徵機關核定數為準。但公司申請適用此投資抵減時，暫以營利事業所得稅結算申報書損益及稅額計算表所載金額核算。若各項比率或適用收入或成本、費用等項目有違反法令情況，稅捐稽徵機關應依所得稅法相關規定調整相關損益科目及金額，核實計算有效稅率。

前瞻創新研究發展適用領域所從事之態樣

所定前瞻創新研究發展，除有委外必要之研究發展活動外，以建立公司自主研究發展能力為原則，限於公司研究發展單位於前瞻創新研究發展適用領域所從事之下列態樣：

一、為開發或設計新產品、新服務之生產程序、服務流程或系統及其原型所從事之研究發展活動。

二、為開發新原料、新材料或零組件所從事之研究發展活動。

此所定態樣，不含為改進現有產品或服務之生產程序、服務流程或系統及現有原料、材料或零組件所從事之研究發展活動。所稱研究發展單位，指公司內部專責從事研究發展活動之單位。

適用前瞻創新研究發展之支出的範圍

所稱前瞻創新研究發展之支出，指公司之下列費用或支出：

一、公司研究發展單位從事前瞻創新研究發展活動所支出之下列費用：

(一) 專門從事研究發展工作全職人員之薪資。

(二) 具完整進、領料紀錄，並能與研究計畫及紀錄或報告相互勾稽，專供研究發展單位研究用之消耗性器材、原料、材料及樣品之費用。

(三) 專為研究發展購買或使用之專利權、專用技術及著作權之當年度攤折或支付費用。

(四) 專為用於研究發展所購買或使用之專業性或特殊性資料庫、軟體程式及系統之當年度攤折或支付費用。

(五) 專門從事研究發展工作全職人員參與研究發展專業知識之教育訓練費用。

二、個別研究發展計畫有部分委外必要者，其下列委外研究發展費用：

(一) 委託國內大專校院或研究機構研究，或聘請國內大專校院專任教師或研究機構研究人員之費用。

(二) 委託國外大專校院或研究機構研究，或聘請國外大專校院專任教師或研究機構研究人員之費用。

三、公司研究發展單位為從事前瞻創新研究發展活動，與國內外公司、大專校院或研究機構共同研究發展所為之支出。

前述所定購買專用技術、軟體、或委託國外研究費用及共同研發支出等事項，應以經濟部審查核准者為限。且國內研究機構，包括政府之研究機關（構）、經政府核准登記有案以研究為主要目的之財團法人、社團法人及其所屬研究機構。

所定教育訓練，應為執行前瞻創新研究發展計畫所需，包括自行辦理、委託辦理或與其他公司、有限合夥事業或相關團體聯合辦理，且指派所屬專門從事研究發展工作全職人員參與研究發展專業知識之教育訓練；其費用範圍如下：

- 一、師資之鐘點費及旅費。
- 二、受訓員工之旅費及繳交訓練單位之費用。
- 三、教材費、保險費、訓練期間伙食費及場地費。

前項教育訓練屬委託辦理部分，該受託辦理訓練活動之公司不得以其所代辦之教育訓練費用適用本辦法之投資抵減；屬與其他公司、有限合夥事業或相關團體聯合辦理部分，其屬該其他公司、有限合夥事業或相關團體應分攤之聯合辦理費用，不得適用本投資抵減。

研究發展之支出排除及特別規定

三、本租稅優惠規定之影響

此租稅優惠的適用對象為國內大型跨國投資國際企業，對其特定項目投資的租稅政策，於政府公告的適用範圍中，能瞭解國家中長期經濟發展引導鼓勵的方向。這項優惠適用的條件及金額門檻高，也僅適用於特定產業或產品服務的投資，一般中小企業無法符合適用此規定。但因為限制投資的地點及支出以國內地區為主，接間使得擁有相關技術專業單位、人士或供應鏈上游的國內中小企業可能受益，因為國際企業的投資意願提高而創造就業的機會或營業收入。

這些大型國際代表性公司，在台灣本身應已經符合多項租稅優惠的機會或條件，在同時適用各項優惠政策時，又受到最低稅負基本稅額或有效稅率的限制，很可能無法完整享受到此規定帶來的優惠。若擬讓企業的租稅優惠能極大化享用，將對各項優惠政策及財務數字的影響分年度作預測或精算，更或是對國內外關係企業組織的營運策略作調整，才較能達成期待。政府此項優惠政策的規定，除期待台灣企業能持續維持國際競爭力外，亦期待能有更多的資源及技術根留台灣。

本文僅以產業創新條例及其相關辦法的內容整理說明並作個人的論述，相關法規主管機關仍可能再變動或另行解釋，因此可能與本文內容相異。同時本文亦無法對各營利事業或股東的特別情況作各別的分析或評估，因此建議在適用本規定時，應再行向專業人員或主管單位作確認或查詢。